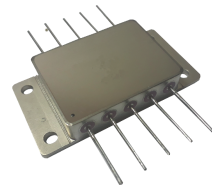


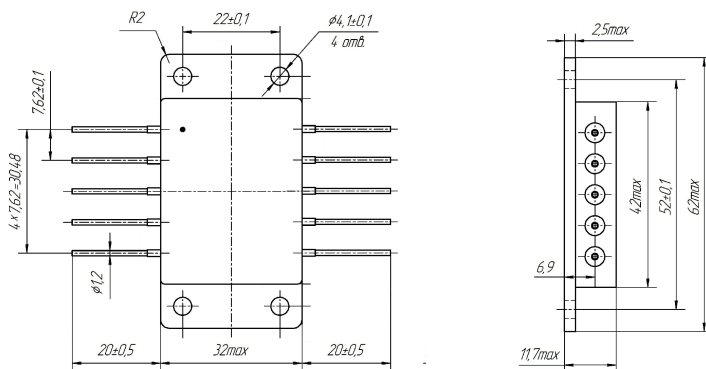
# МОДУЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

## КМ410Б1, КМ410В1

Мощные полупроводниковые модули в металлокерамических корпусах с изолированным фланцем предназначены для использования в системах электроснабжения, в преобразовательной технике и другой аппаратуре широкого применения, изготавливаемой для народного хозяйства.



Масса модуля не более 70 г.



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ ЯАВД.432325.017ГЧ

Модули соответствуют АДКБ.432170.504ТУ.

Таблица 1. Основные электрические параметры при  $T = 25^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма	
		КМ410Б1	КМ410В1
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА ( $U_{КЭ} = 1700\text{ В}, U_{ЗЭ} = 0$ )	$I_{КЭК}$	$\leq 2$	
( $U_{КЭ} = 1200\text{ В}, U_{ЗЭ} = 0$ )			$\leq 2$
Ток утечки затвора ( $U_{КЭ} = 0, U_{ЗЭ} = \pm 20\text{ В}$ ), нА	$I_{з, ут}$	$\leq 500$	$\leq 500$
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ( $I_{КЭ} = 50\text{ А}, U_{ЗЭ} = 15\text{ В}$ )	$U_{КЭ, нас}$	$\leq 3,5$	
( $I_{КЭ} = 100\text{ А}, U_{ЗЭ} = 15\text{ В}$ )			$\leq 2,8$
Пороговое напряжение затвор-эмиттер ( $I_{К} = 1\text{ мА}$ ), В	$U_{ЗЭ, пор}$	2,5 – 6,5	2,5 – 6,5
Постоянное прямое напряжение диода, В ( $I_{ПР} = 50\text{ А}$ )	$U_{ПР}$	$\leq 3,3$	
( $I_{ПР} = 100\text{ А}$ )			$\leq 2,5$
Время включения, нс ( $U_{ЗЭ} = \pm 15\text{ В}, L_{Н} = 0,25\text{ мГн}, U_{КЭ} = 900\text{ В}$ )	$t_{вкл}$	$\leq 400$	
( $U_{ЗЭ} = \pm 15\text{ В}, L_{Н} = 0,25\text{ мГн}, U_{КЭ} = 600\text{ В}$ )			$\leq 400$
Время выключения, нс ( $U_{ЗЭ} = \pm 15\text{ В}, L_{Н} = 0,25\text{ мГн}, U_{КЭ} = 900\text{ В}$ )	$t_{выкл}$	$\leq 800$	
( $U_{ЗЭ} = \pm 15\text{ В}, L_{Н} = 0,25\text{ мГн}, U_{КЭ} = 600\text{ В}$ )			$\leq 800$
Входная емкость ( $U_{КЭ} = 25\text{ В}, U_{ЗЭ} = 0\text{ В}, f = 1\text{ МГц}$ ), нФ	$C_{ВХ}(C_{11Э})$	$\leq 10$	$\leq 10$
Выходная емкость ( $U_{КЭ} = 25\text{ В}, U_{ЗЭ} = 0\text{ В}, f = 1\text{ МГц}$ ), нФ	$C_{ВЫХ}(C_{22Э})$	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$
Время обратного восстановления диода ( $U_{ЗЭ} = \pm 15\text{ В}, L_{Н} = 0,25\text{ мГн}, U_{КЭ} = 900\text{ В}$ ), нс	$t_{вос. обр}$	$\leq 800$	$\leq 800$
Тепловое сопротивление переход-корпус, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Т,ПК}$	$\leq 0,36$	$\leq 0,36$

Таблица 2. Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма	
		КМ410Б1	КМ410В1
Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер, В	$U_{КЭ.мах}$	1700	1200
Максимально допустимое напряжение коллектор-затвор, В	$U_{КЗ.мах}$	1700	1200
Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер, В	$U_{ЗЭ.мах}$	$\pm 20$	$\pm 20$
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{К.мах}$	100	50
Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, А	$I_{ПР.мах}$	100	50
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{К(и)мах}$	200	100
Максимально допустимый импульсный прямой ток диода, А	$I_{ПР(и)мах}$	200	100
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность модуля при температуре корпуса от 60 до плюс 25 °С, Вт	$P_{Кмах}$	350	350